

# HA1630S01/02/03 シリーズ

R03DS0081JJ0400

Rev.4.00

2014.01.10

## 超小型低電圧駆動 CMOS シングルオペアンプ

### 概要

HA1630S01/02/03 は、低電圧駆動可能な低入力オフセット電圧、低消費電流を実現したシングル CMOS オペアンプです。

本 IC は、電源電圧 1.8V から動作が可能で、出力は電源電圧範囲内でフルスイング動作が可能です。

また、パッケージは超小型の CMPAK-5V に搭載しており、その実装面積は SOP パッケージに比べて約 1/8 となります。

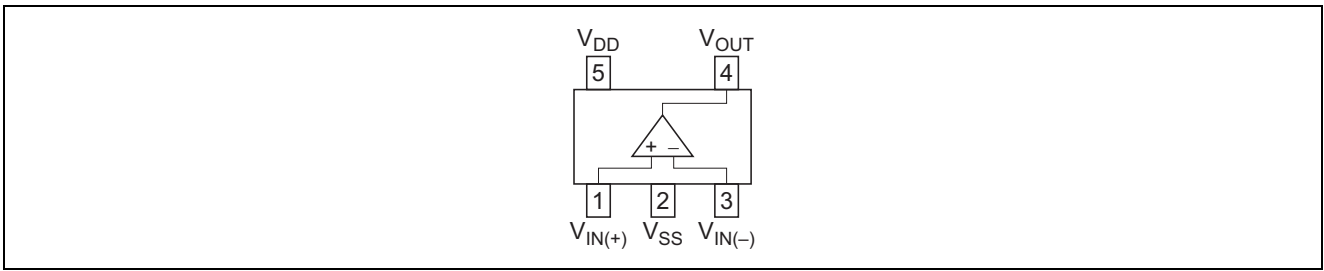
### 特長

- 低電圧単一電源動作  $V_{DD} = 1.8 \sim 5.5 \text{ V}$
- 低入力オフセット電圧  $V_{IO} = 4.0 \text{ mV Max}$
- 低消費電流
  - $I_{DD} = 15 \mu\text{A Typ (HA1630S01)}$
  - $I_{DD} = 50 \mu\text{A Typ (HA1630S02)}$
  - $I_{DD} = 100 \mu\text{A Typ (HA1630S03)}$
- 最大出力電圧  $V_{OH} = 2.9 \text{ V Min (} V_{DD} = 3.0 \text{ V 時)}$
- 低入力バイアス電流  $I_{IB} = 1 \text{ pA Typ}$

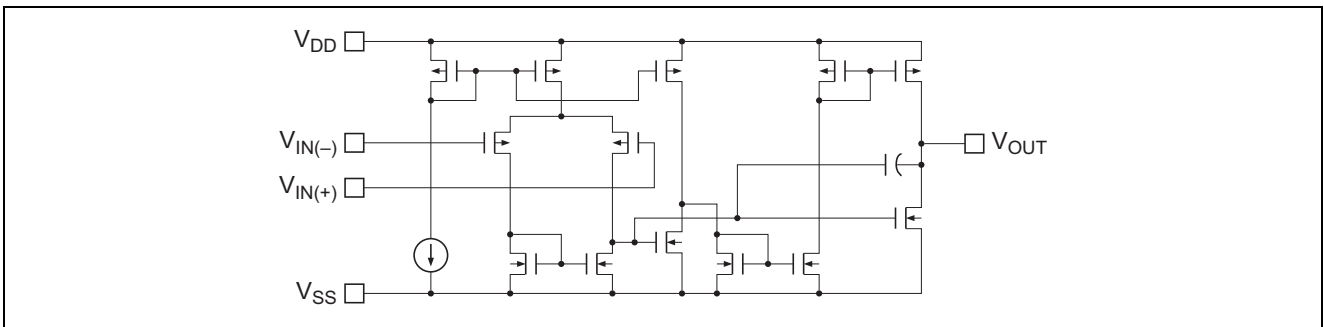
### 製品ラインアップ

型名	パッケージ名称	パッケージコード
HA1630S01CM	CMPAK-5	PTSP0005ZC-A
HA1630S01LP	MPAK-5	PLSP0005ZB-A
HA1630S02CM	CMPAK-5	PTSP0005ZC-A
HA1630S02LP	MPAK-5	PLSP0005ZB-A
HA1630S03CM	CMPAK-5	PTSP0005ZC-A
HA1630S03LP	MPAK-5	PLSP0005ZB-A

## ピン配置



## 内部回路図



## 絶対最大定格

(Ta = 25°C)

項目	記号	定格値	単位	注
電源電圧	V <sub>DD</sub>	7	V	
差動入力電圧	V <sub>IN(diff)</sub>	-V <sub>DD</sub> ~ +V <sub>DD</sub>	V	
入力電圧	V <sub>IN</sub>	-0.3 ~ +V <sub>DD</sub>	V	1
許容損失	P <sub>T</sub>	200	mW	
動作温度	T <sub>opr</sub>	-40 ~ +85	°C	
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55 ~ +125	°C	

【注】 1. V<sub>DD</sub> または 7 V を越える入力電圧を印加しないこと。

## 電気的特性

(V<sub>DD</sub> = 3.0 V, Ta = 25°C)

項目	記号	Min	Typ	Max	単位	測定条件
入力オフセット電圧	V <sub>IO</sub>	—	—	4.0	mV	V <sub>in</sub> = 1.5 V
入力オフセット電流	I <sub>IO</sub>	—	(1.0)	—	pA	V <sub>in</sub> = 1.5 V
入力バイアス電流	I <sub>IB</sub>	—	(1.0)	—	pA	V <sub>in</sub> = 1.5 V
出力ハイ電圧	V <sub>OH</sub>	2.9	—	—	V	R <sub>L</sub> = 1 MΩ
出力ソース電流	I <sub>O SOURCE</sub>	6	12	—	μA	V <sub>OH</sub> = 2.5 V (HA1630S01)
		25	50	—		V <sub>OH</sub> = 2.5 V (HA1630S02)
		50	100	—		V <sub>OH</sub> = 2.5 V (HA1630S03)
出力ロー電圧	V <sub>OL</sub>	—	—	0.1	V	R <sub>L</sub> = 1 MΩ
出力シンク電流	I <sub>O SINK</sub>	—	(0.8)	—	mA	V <sub>OL</sub> = 0.5 V (HA1630S01)
		—	(1.0)	—		V <sub>OL</sub> = 0.5 V (HA1630S02)
		—	(1.2)	—		V <sub>OL</sub> = 0.5 V (HA1630S03)
同相入力電圧範囲	V <sub>CM</sub>	-0.1 ~ 2.1	—	—	V	
スルーレート	SR	—	(0.125)	—	V/μs	C <sub>L</sub> = 20 pF (HA1630S01)
		—	(0.50)	—		C <sub>L</sub> = 20 pF (HA1630S02)
		—	(1.00)	—		C <sub>L</sub> = 20 pF (HA1630S03)
電圧利得	A <sub>V</sub>	60	100	—	dB	
帯域幅	BW	—	(200)	—	kHz	C <sub>L</sub> = 20 pF (HA1630S01)
		—	(680)	—		C <sub>L</sub> = 20 pF (HA1630S02)
		—	(1200)	—		C <sub>L</sub> = 20 pF (HA1630S03)
電源電圧除去比	PSRR	60	80	—	dB	
同相弁別比	CMRR	60	80	—	dB	
消費電流	I <sub>DD</sub>	—	15	30	μA	R <sub>L</sub> = ∞ (HA1630S01)
		—	50	100		R <sub>L</sub> = ∞ (HA1630S02)
		—	100	200		R <sub>L</sub> = ∞ (HA1630S03)

【注】 ( ) 内は設計参考値を示します。

## 電氣的特性図一覧表

電氣的特性			HA1630S01 図	HA1630S02 図	HA1630S03 図	測定 回路図
電源電流	$I_{DD}$	対 電源電圧特性	1-1	2-1	3-1	2
		対 温度特性	1-2	2-2	3-2	
出力ハイ電圧	$V_{OH}$	対 出力ソース電流特性	1-3	2-3	3-3	4
		対 電源電圧特性	1-4	2-4	3-4	
出力ソース電流	$I_{OSOURCE}$	対 温度特性	1-5	2-5	3-5	6
出力ロー電圧	$V_{OL}$	対 出力シンク電流特性	1-6	2-6	3-6	5
出力シンク電流	$I_{OSINK}$	対 温度特性	1-7	2-7	3-7	6
入力オフセット電圧	$V_{IO}$	分布	1-8	2-8	3-8	1
		対 電源電圧特性	1-9	2-9	3-9	
		対 温度特性	1-10	2-10	3-10	
同相入力電圧範囲	$V_{CM}$	対 温度特性	1-11	2-11	3-11	7
電源電圧除去比	PSRR	対 周波数特性	1-12	2-12	3-12	1
同相弁別比	CMRR	対 周波数特性	1-13	2-13	3-13	7
電圧利得と帯域幅	$A_V$	対 周波数特性	1-14	2-14	3-14	10
入力バイアス電流	$I_{IB}$	対 温度特性	1-15	2-15	3-15	3
		対 入力電圧特性	1-16	2-16	3-16	
スルーレート (立ち上がり)	$SR_r$	対 温度特性	1-17	2-17	3-17	9
スルーレート (立ち下がり)	$SR_f$	対 温度特性	1-18	2-18	3-18	
スルーレート		大信号過渡応答	1-19	2-19	3-19	
		小信号過渡応答	1-20	2-20	3-20	
全高調波歪 + ノイズ	(0 dB)	対 出力電圧振幅	—	2-21	3-21	8
	(40 dB)	対 出力電圧振幅	—	2-22	3-22	
最大電力振幅電圧		対 周波数特性	1-21	2-23	3-23	
入力換算ノイズ		対 周波数特性	1-22	2-24	3-24	

主特性 (HA1630S01)

図 1-1. HA1630S01  
電源電流 対 電源電圧特性

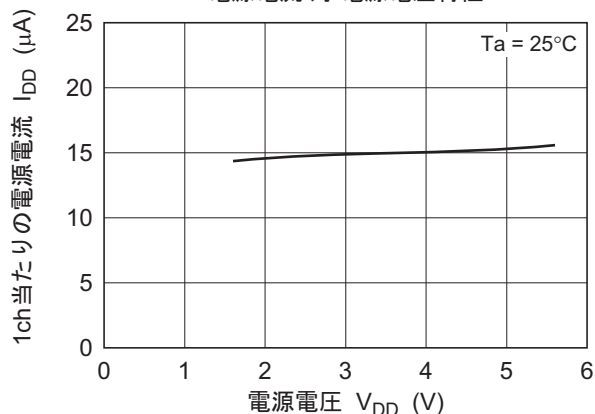


図 1-2. HA1630S01  
電源電流 対 周囲温度特性

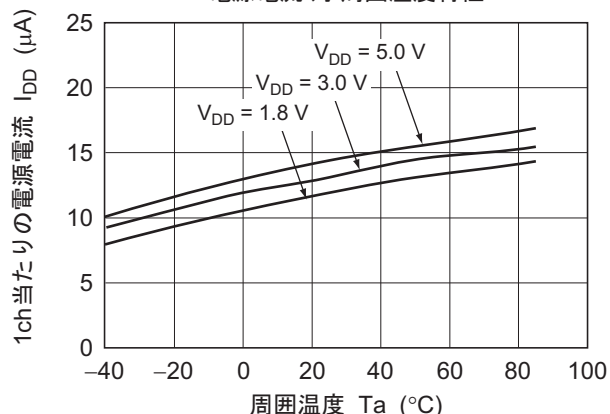


図 1-3. HA1630S01  
出力ハイ電圧 対 出カソース電流特性

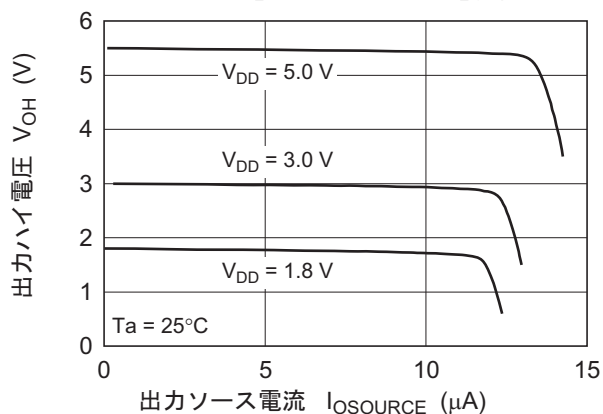


図 1-4. HA1630S01  
出力ハイ電圧 対 電源電圧特性

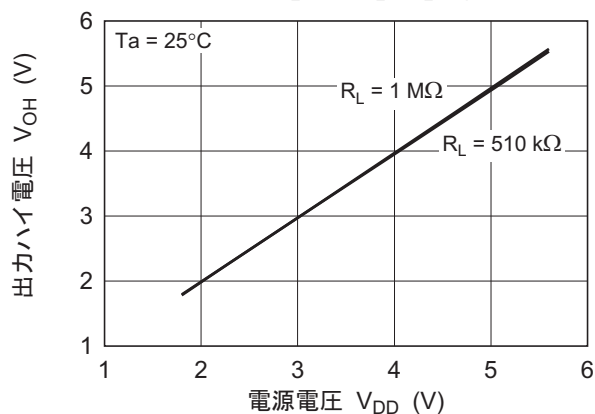
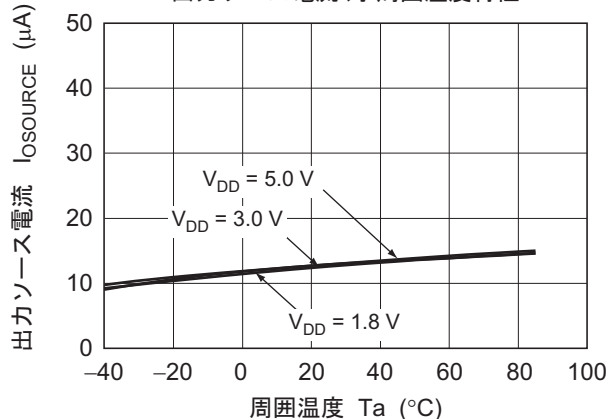


図 1-5. HA1630S01  
出カソース電流 対 周囲温度特性



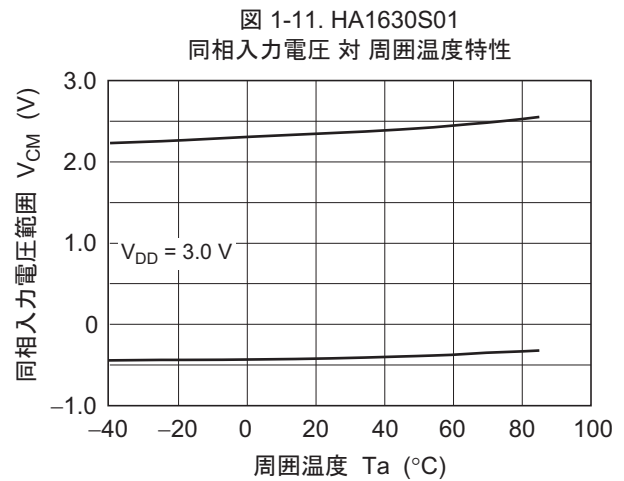
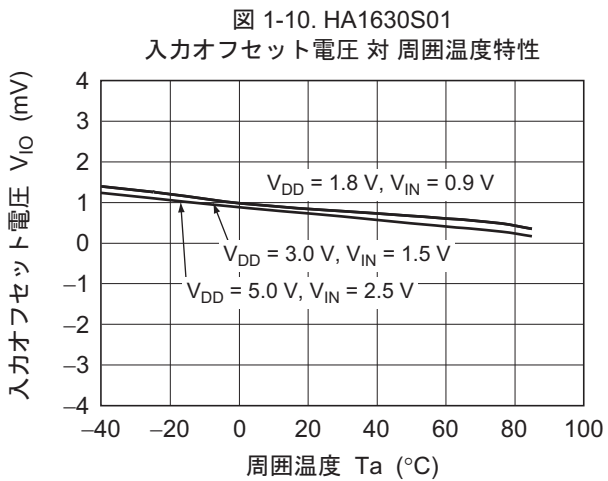
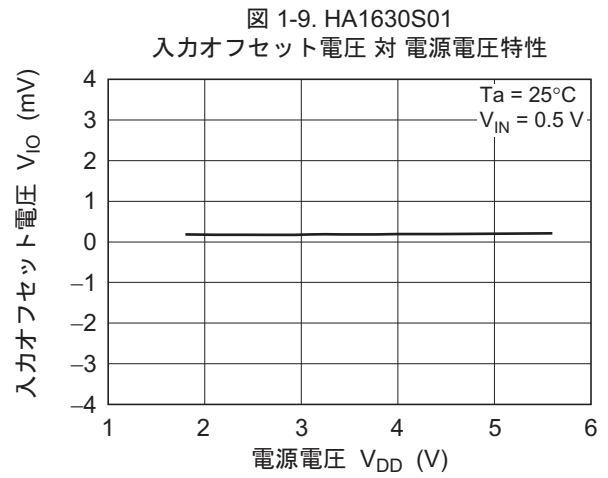
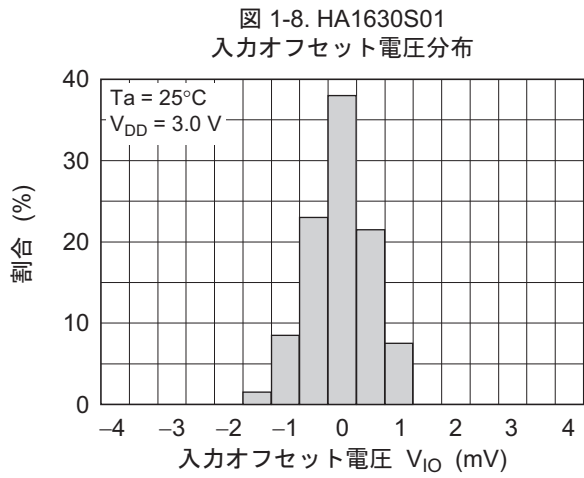
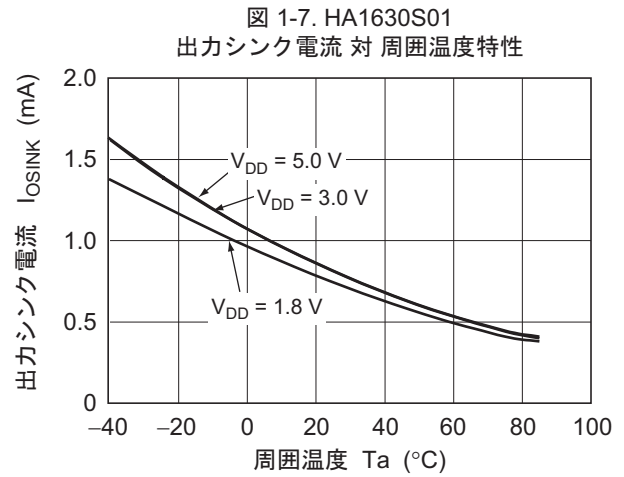
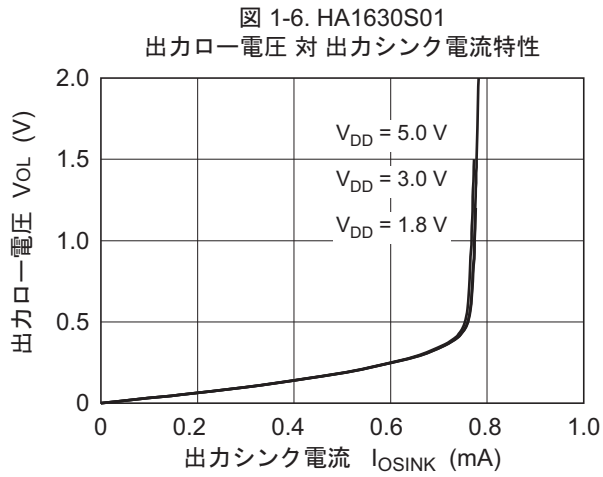


図 1-12. HA1630S01  
電源電圧除去比 対 周波数特性

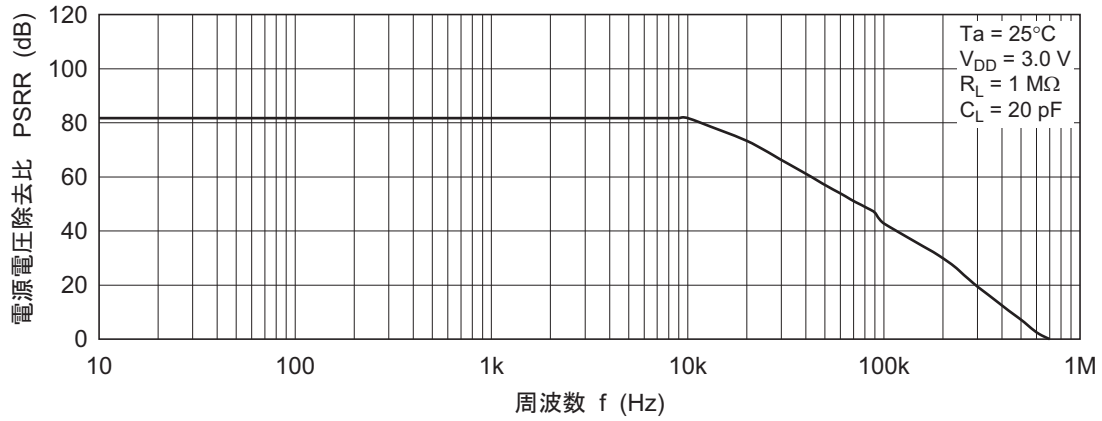


図 1-13. HA1630S01  
同相弁別比 対 周波数特性

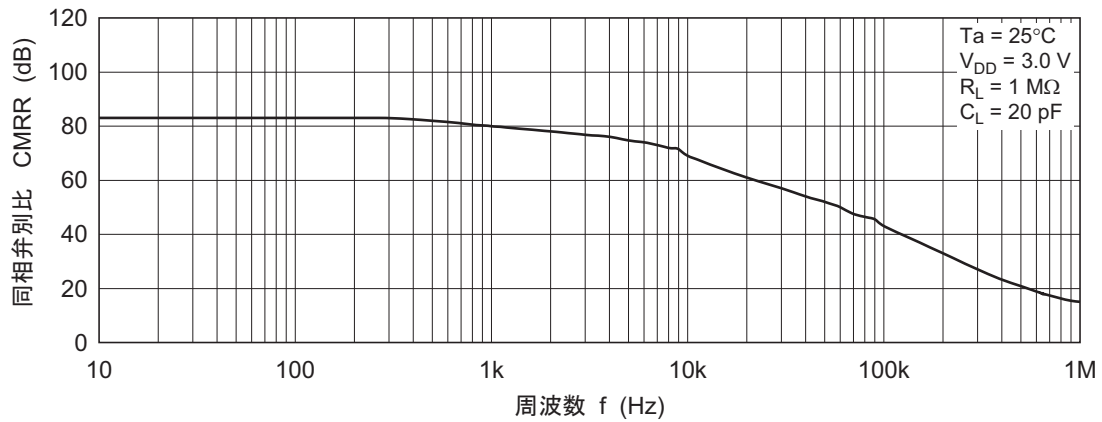


図 1-14. HA1630S01  
開ループ電圧利得, 位相 対 周波数特性

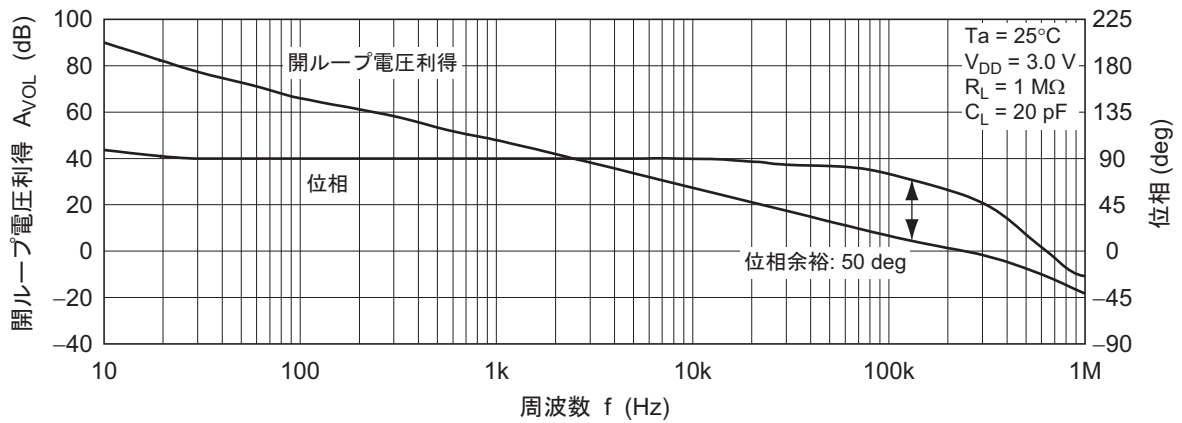


図 1-15. HA1630S01  
入力バイアス電流 対 周囲温度特性

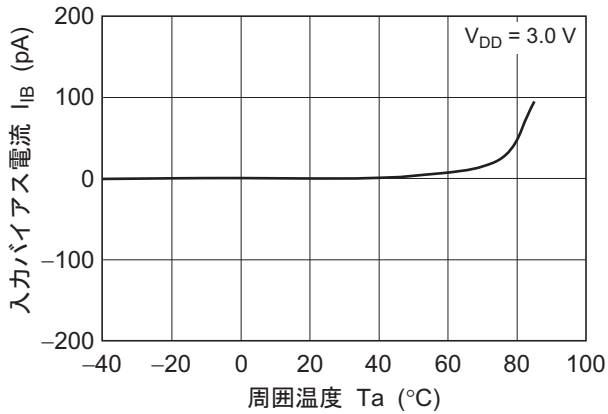


図 1-16. HA1630S01  
入力バイアス電流 対 入力電圧特性

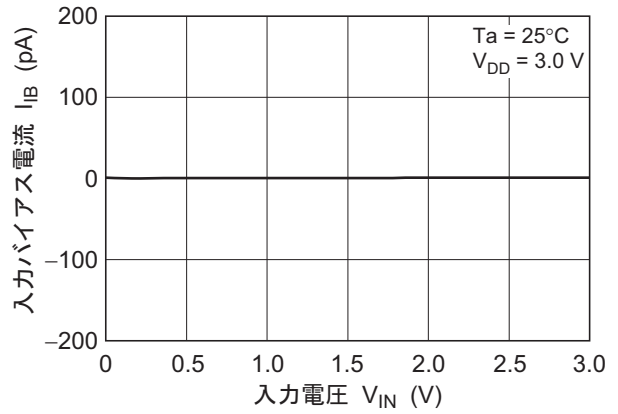


図 1-17. HA1630S01  
スルーレート (立ち上がり) 対 周囲温度特性

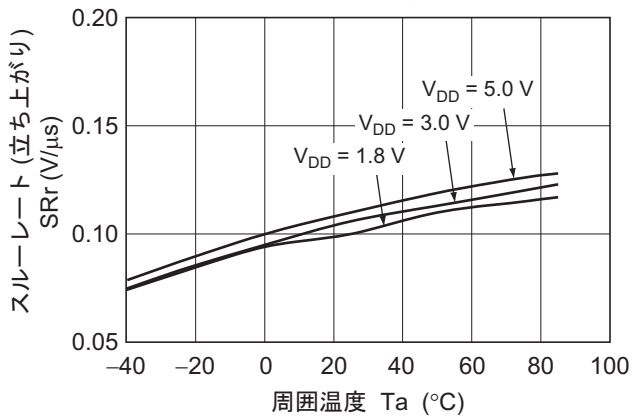


図 1-18. HA1630S01  
スルーレート (立ち下がり) 対 周囲温度特性

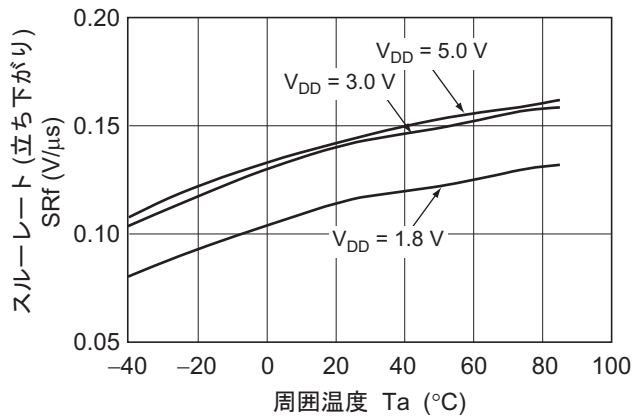


図 1-19. HA1630S01  
大振幅過渡応答特性

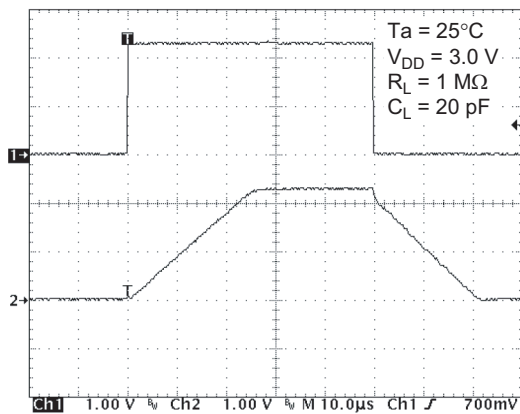


図 1-20. HA1630S01  
小振幅過渡応答特性

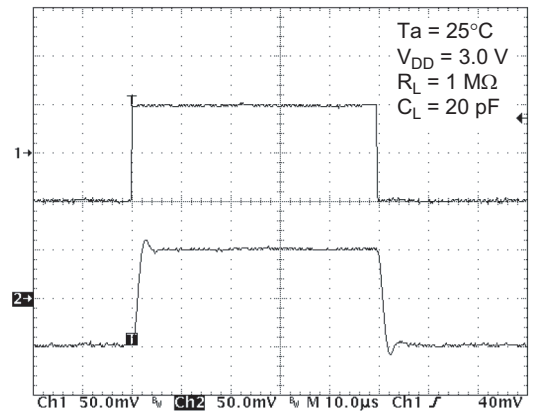




図 1-21. HA1630S01  
最大出力振幅電圧 対 周波数特性

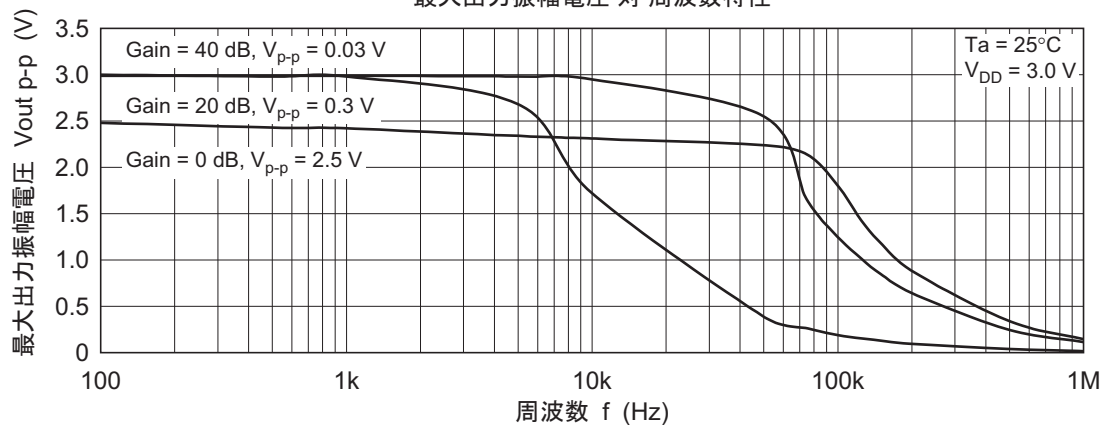
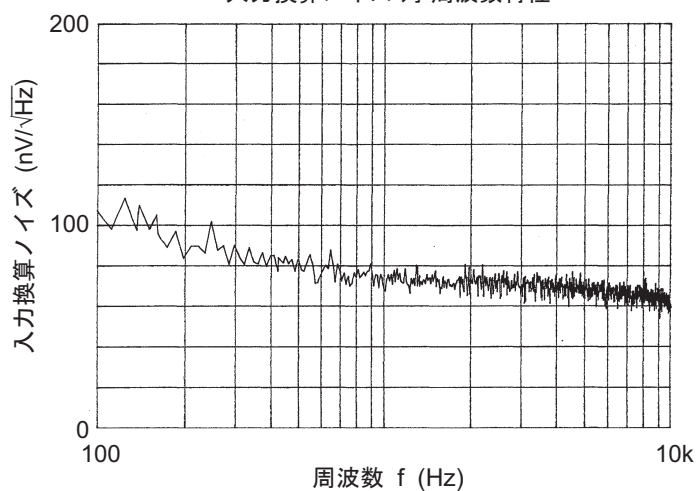


図 1-22. HA1630S01  
入力換算ノイズ 対 周波数特性



主特性 (HA1630S02)

図 2-1. HA1630S02  
電源電流 対 電源電圧特性

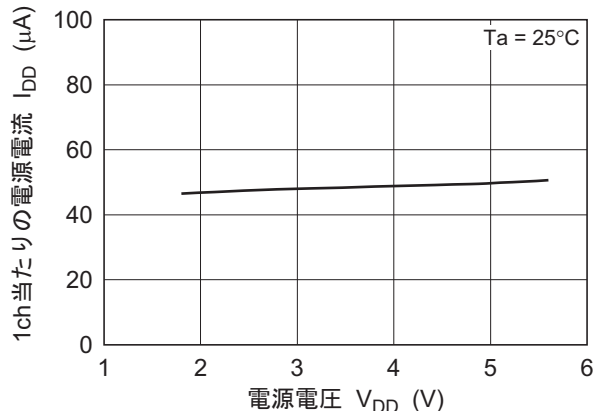


図 2-2. HA1630S02  
電源電流 対 周囲温度特性

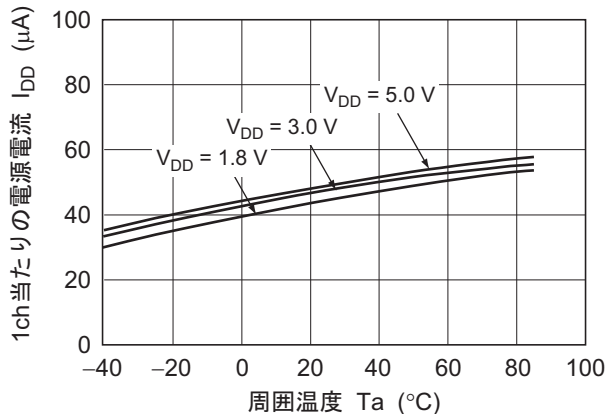


図 2-3. HA1630S02  
出力ハイ電圧 対 出カソース電流特性

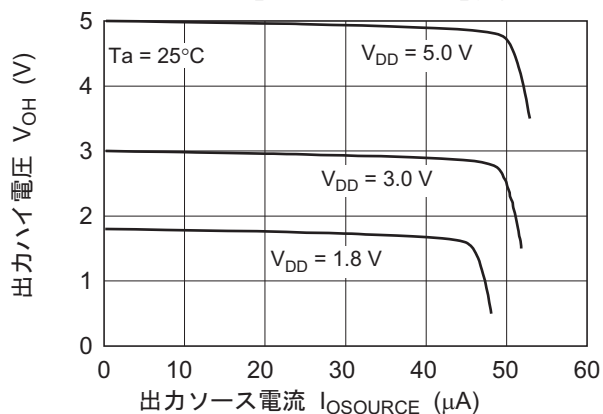


図 2-4. HA1630S02  
出力ハイ電圧 対 電源電圧特性

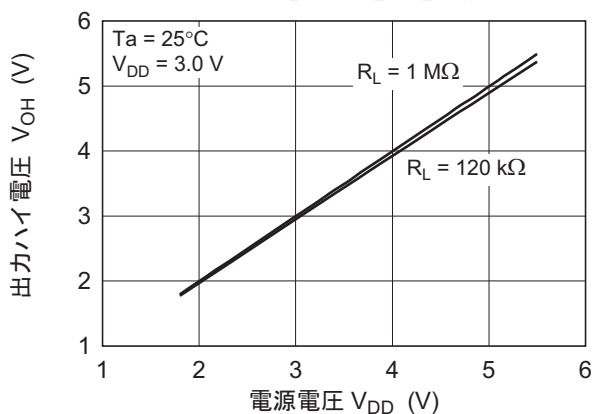
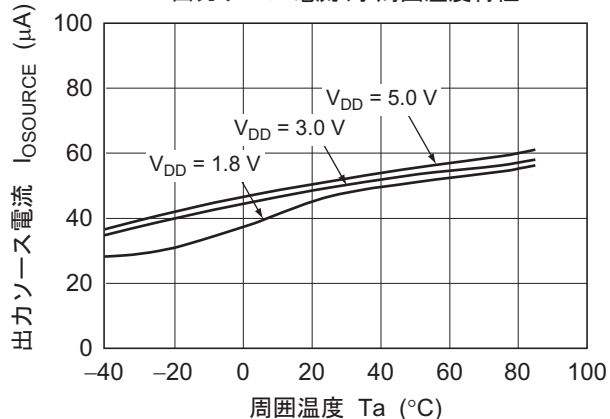


図 2-5. HA1630S02  
出カソース電流 対 周囲温度特性



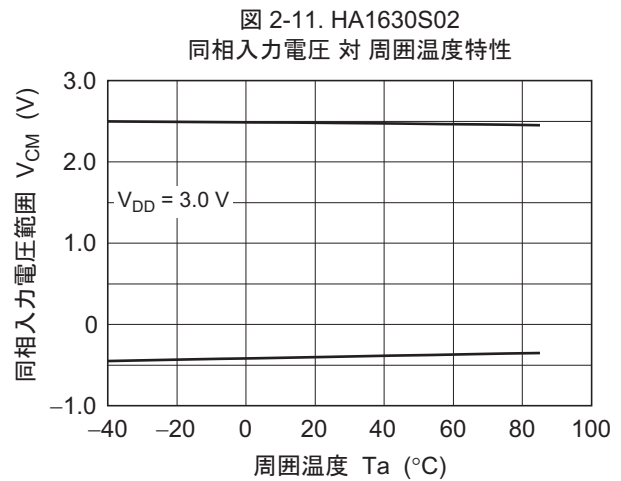
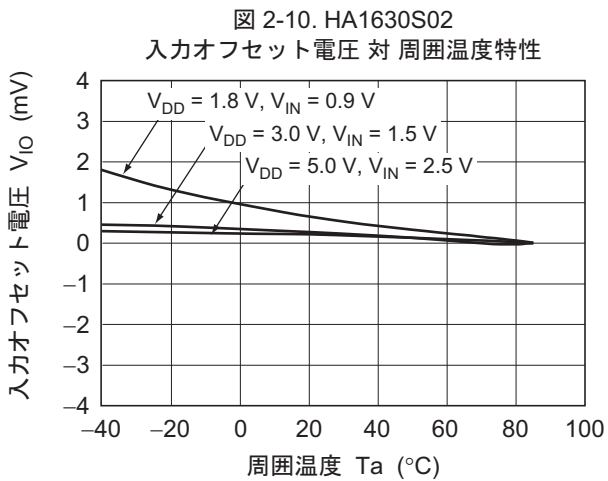
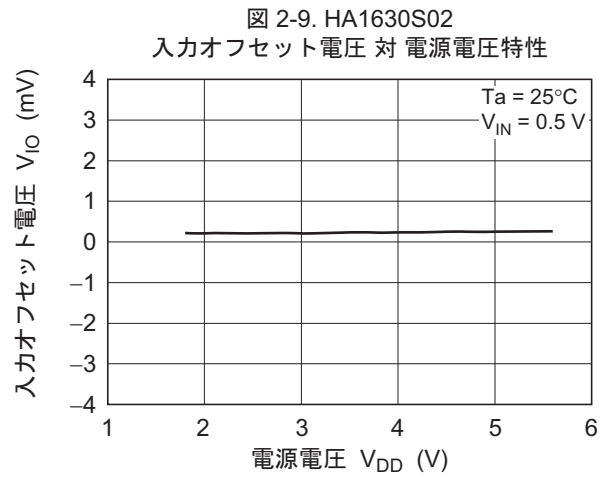
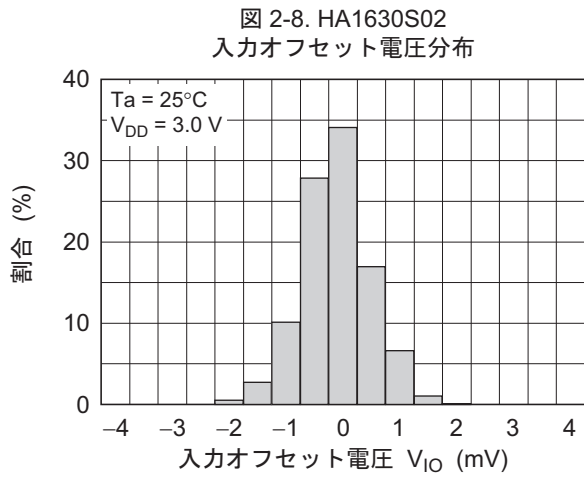
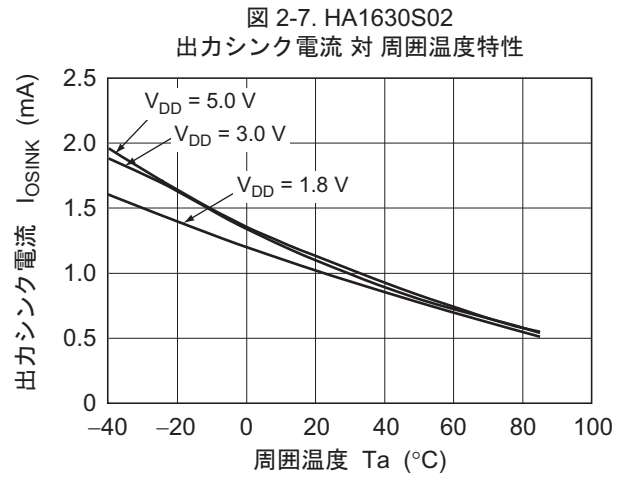
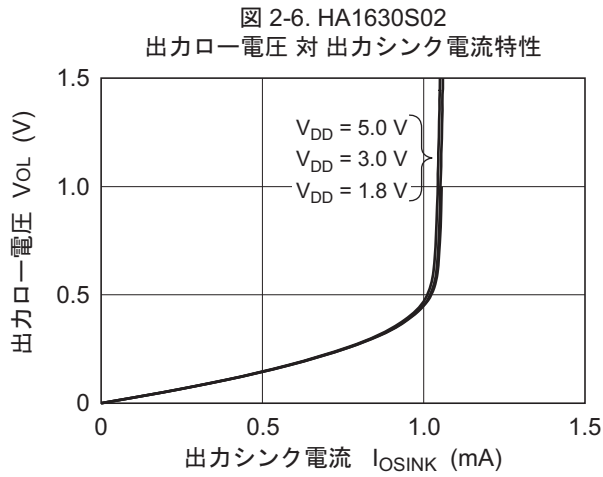


図 2-12. HA1630S02  
電源電圧除去比 対 周波数特性

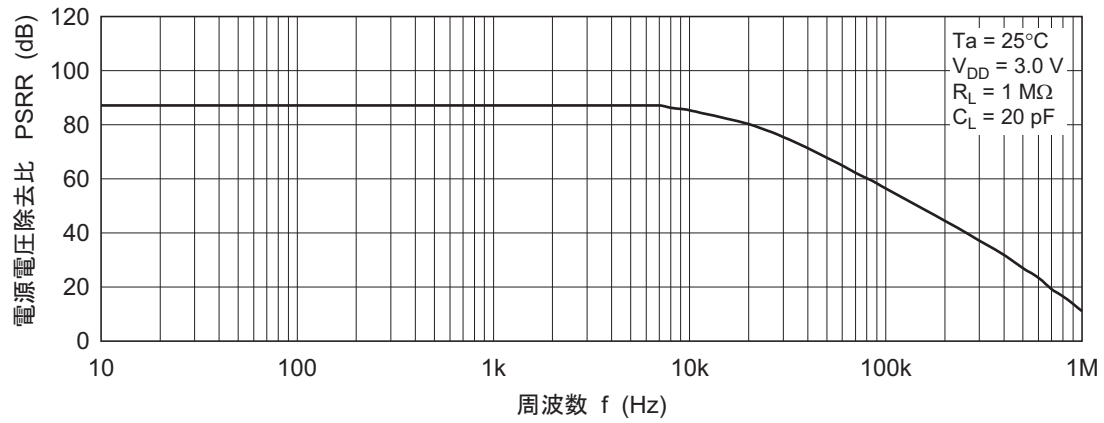


図 2-13. HA1630S02  
同相弁別比 対 周波数特性

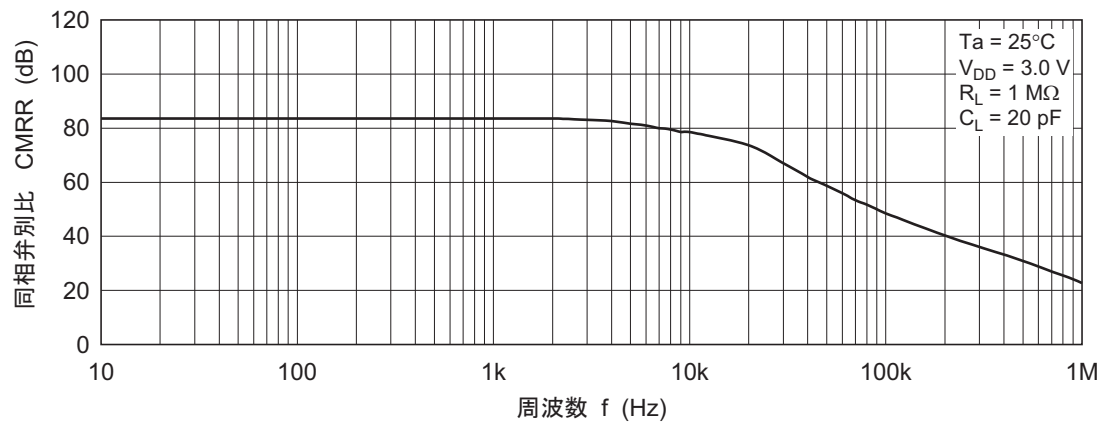


図 2-14. HA1630S02  
開ループ電圧利得, 位相 対 周波数特性

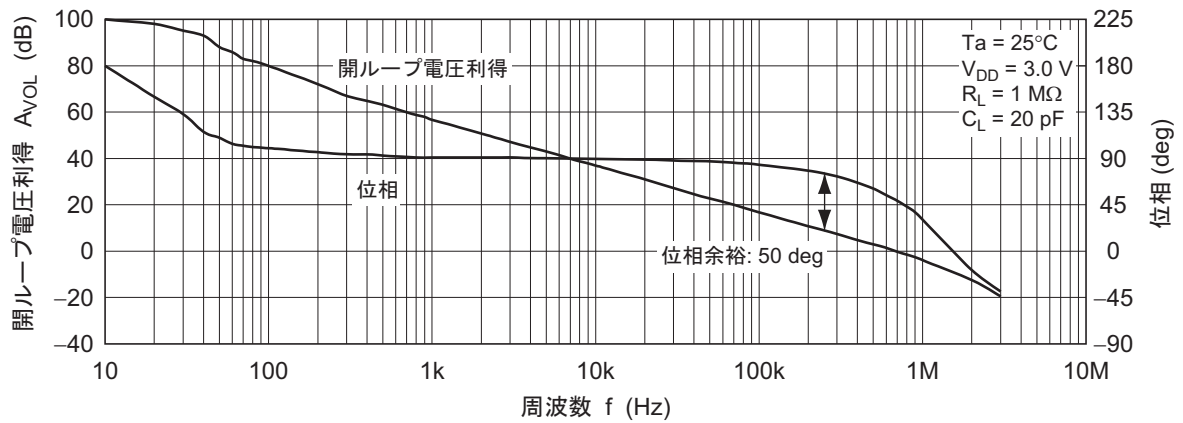


図 2-15. HA1630S02  
入力バイアス電流 対 周囲温度特性

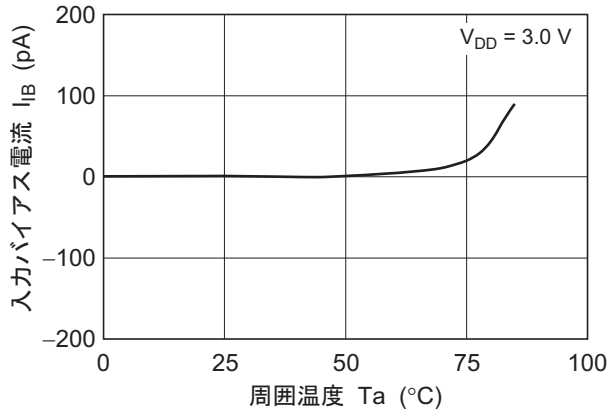


図 2-16. HA1630S02  
入力バイアス電流 対 入力電圧特性

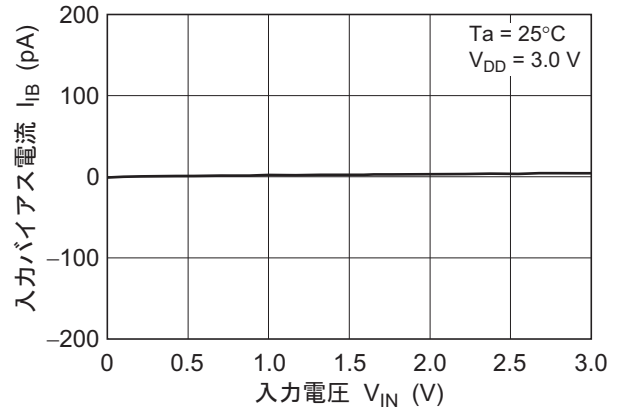


図 2-17. HA1630S02  
スルーレート (立ち上がり) 対 周囲温度特性

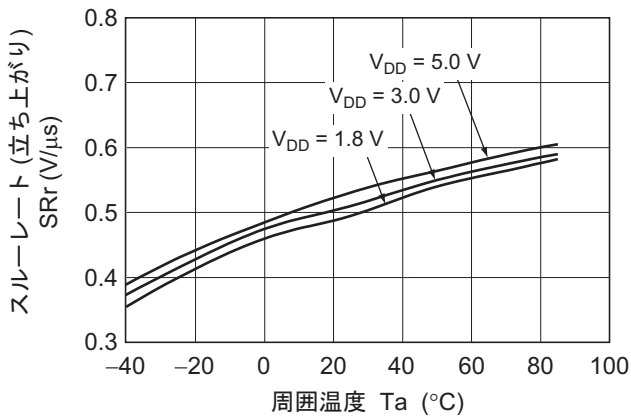


図 2-18. HA1630S02  
スルーレート (立ち下がり) 対 周囲温度特性

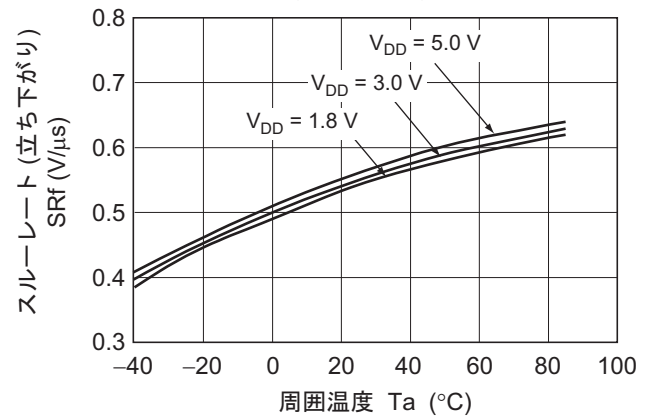


図 2-19. HA1630S02  
大振幅過渡応答特性

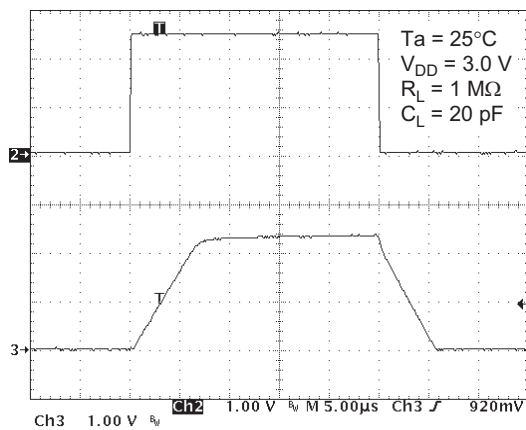


図 2-20. HA1630S02  
小振幅過渡応答特性

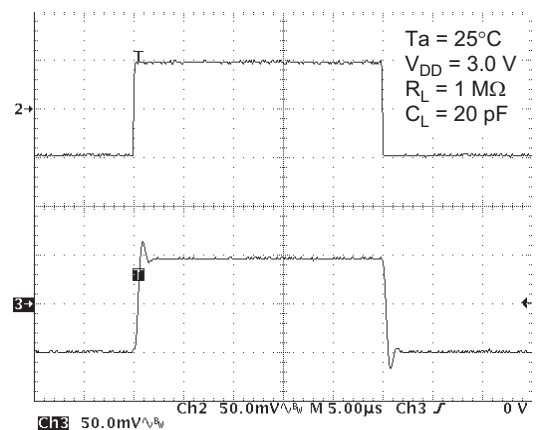


図 2-21. HA1630S02

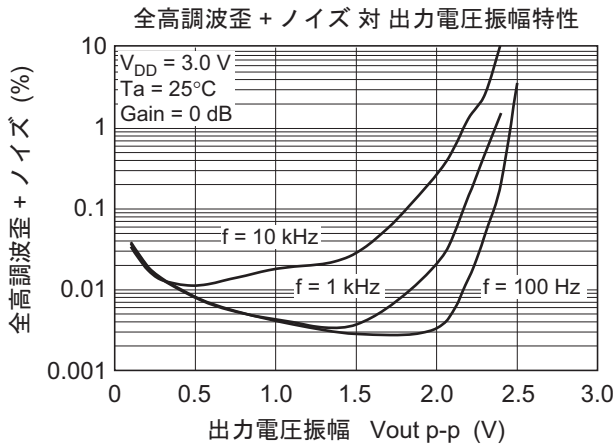


図 2-22. HA1630S02

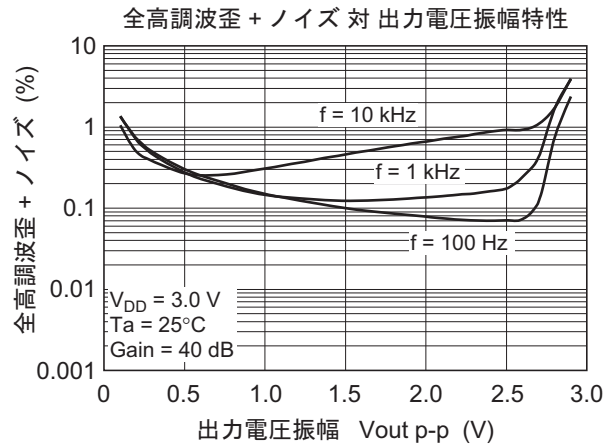


図 2-23. HA1630S02  
 最大出力振幅電圧 対 周波数特性

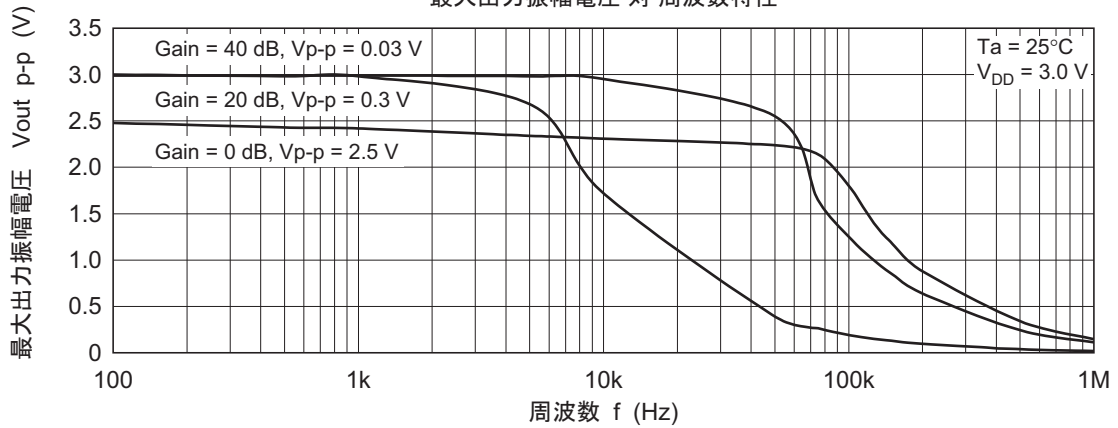
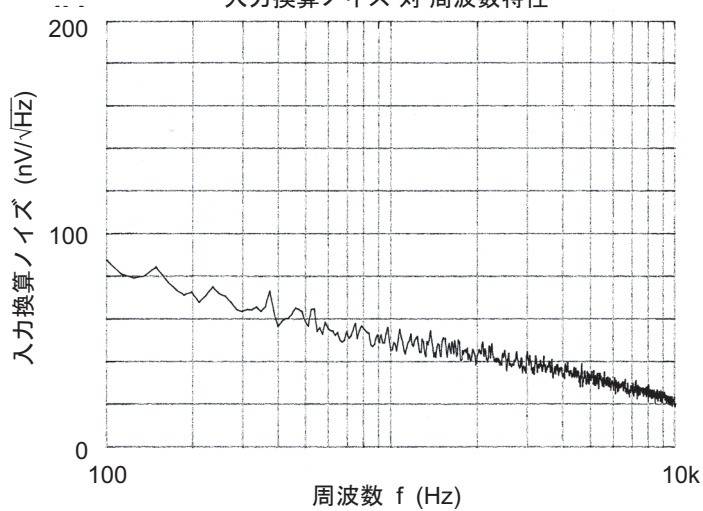


図 2-24. HA1630S02  
 入力換算ノイズ 対 周波数特性



主特性 (HA1630S03)

図 3-1. HA1630S03  
電源電流 対 電源電圧特性

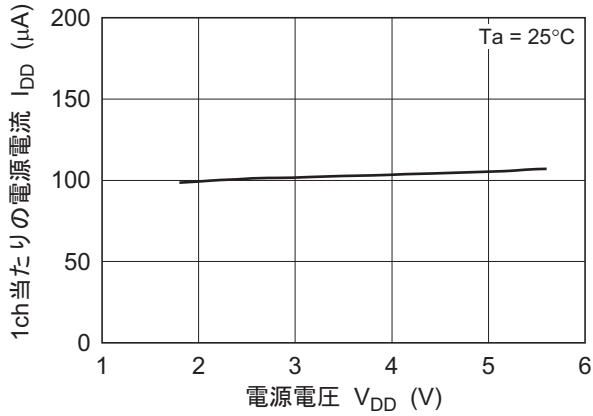


図 3-2. HA1630S03  
電源電流 対 周囲温度特性

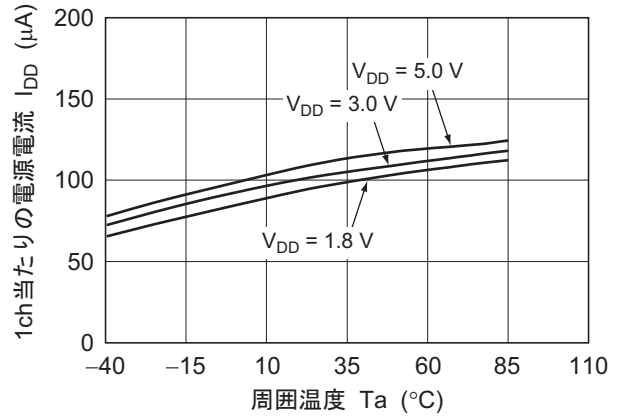


図 3-3. HA1630S03  
出力ハイ電圧 対 出カソース電流特性

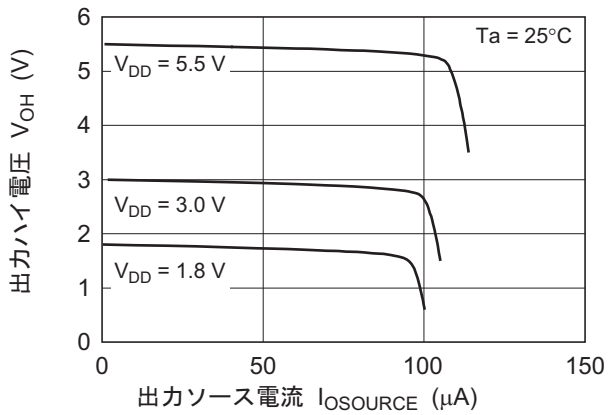


図 3-4. HA1630S03  
出力ハイ電圧 対 電源電圧特性

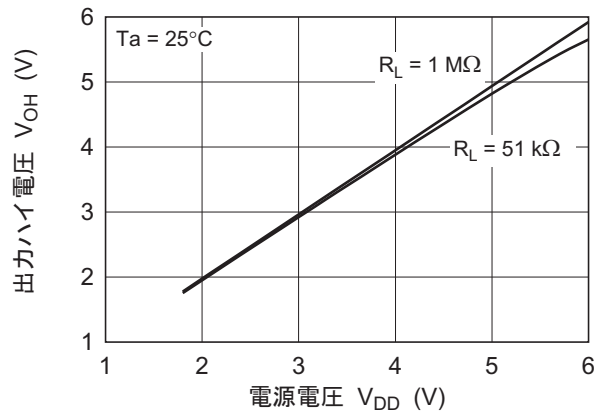


図 3-5. HA1630S03  
出カソース電流 対 周囲温度特性

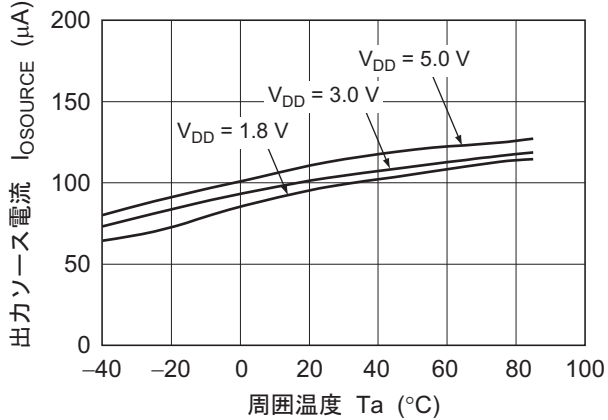


図 3-6. HA1630S03  
出力ロー電圧 対 出力シンク電流特性

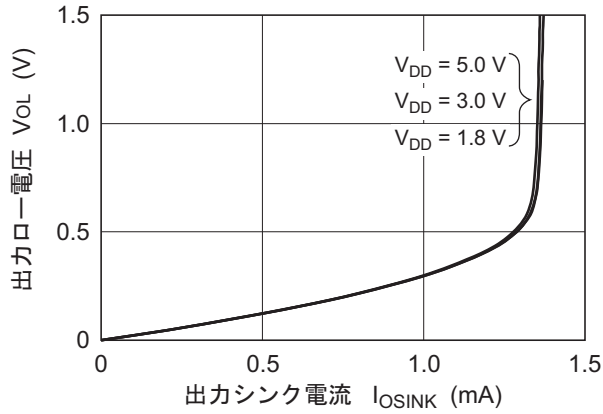


図 3-7. HA1630S03  
出力シンク電流 対 周囲温度特性

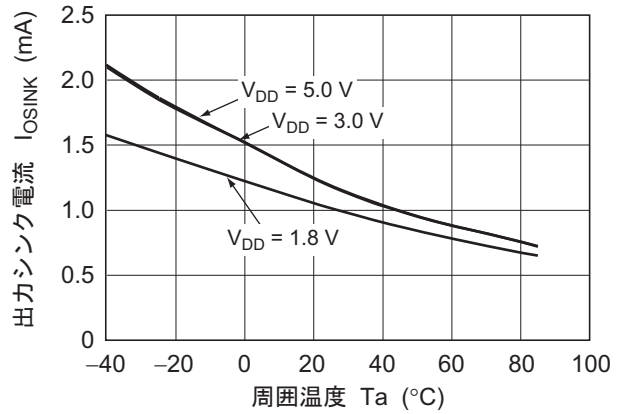


図 3-8. HA1630S03  
入力オフセット電圧分布

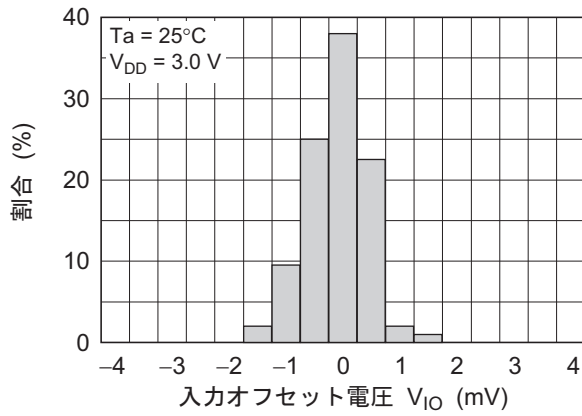


図 3-9. HA1630S03  
入力オフセット電圧 対 電源電圧特性

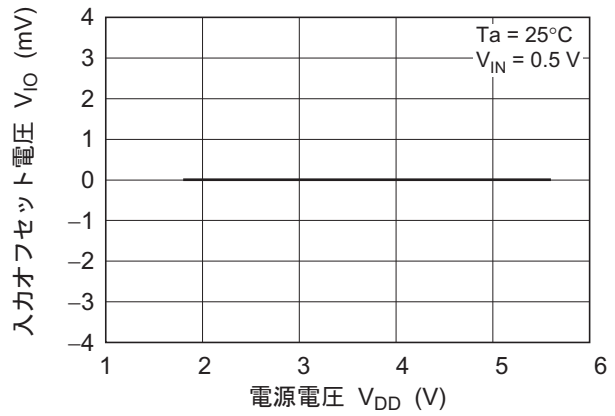


図 3-10. HA1630S03  
入力オフセット電圧 対 周囲温度特性

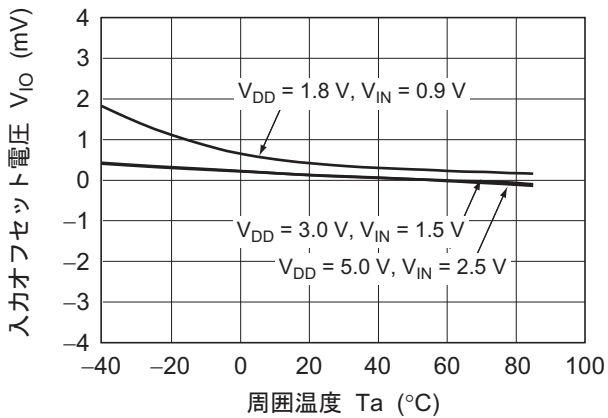


図 3-11. HA1630S03  
同相入力電圧 対 周囲温度特性

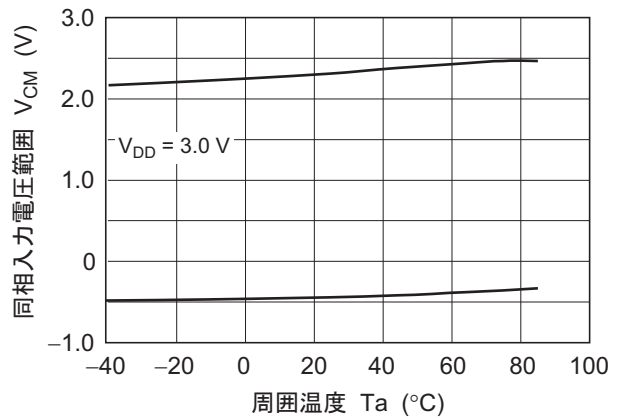




図 3-12. HA1630S03  
電源電圧除去比 対 周波数特性

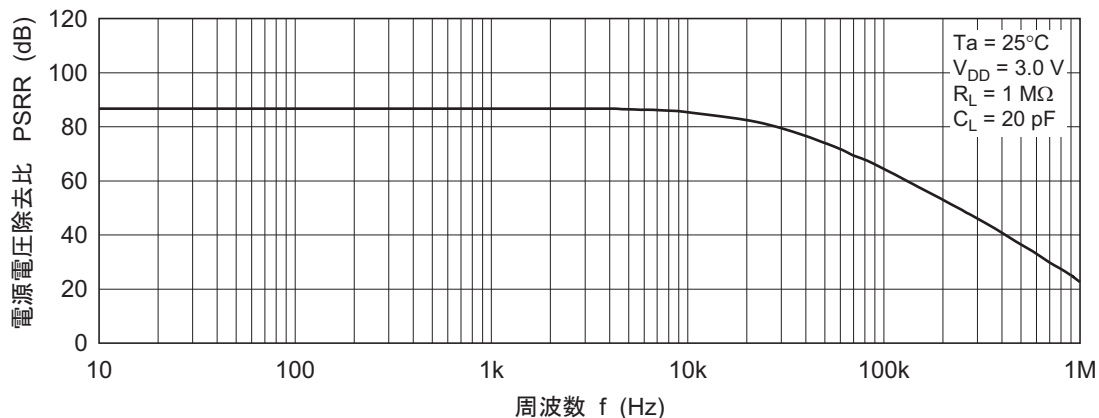


図 3-13. HA1630S03  
同相弁別比 対 周波数特性

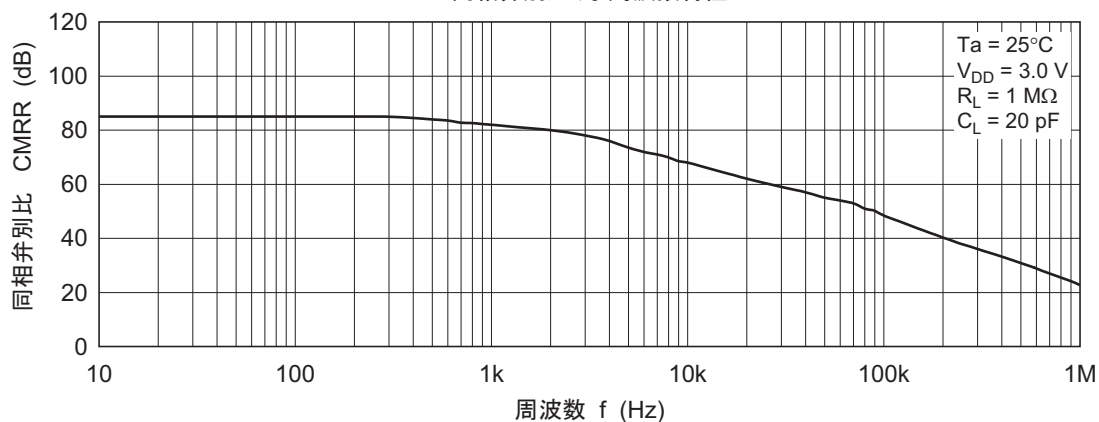


図 3-14. HA1630S03  
開ループ電圧利得, 位相 対 周波数特性

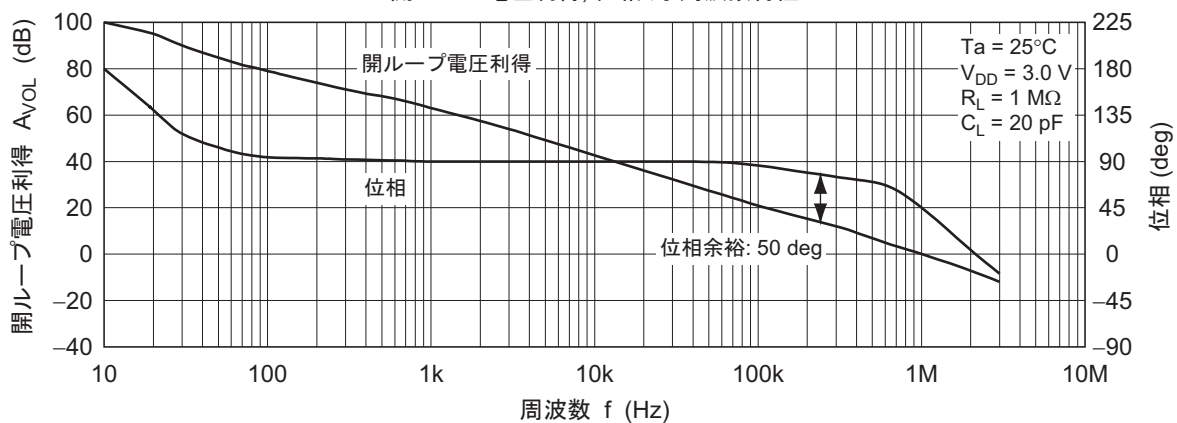


図 3-15. HA1630S03  
入力バイアス電流 対 周囲温度特性

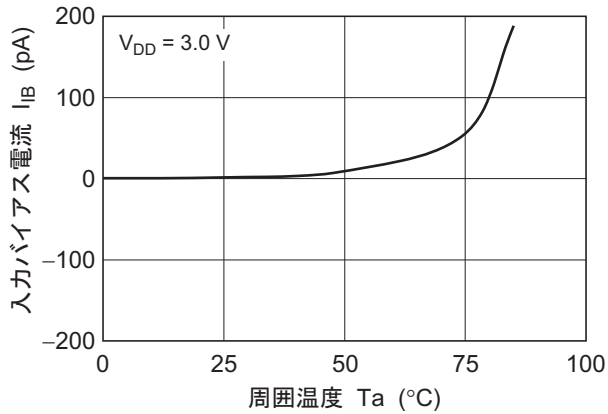


図 3-16. HA1630S03  
入力バイアス電流 対 入力電圧特性

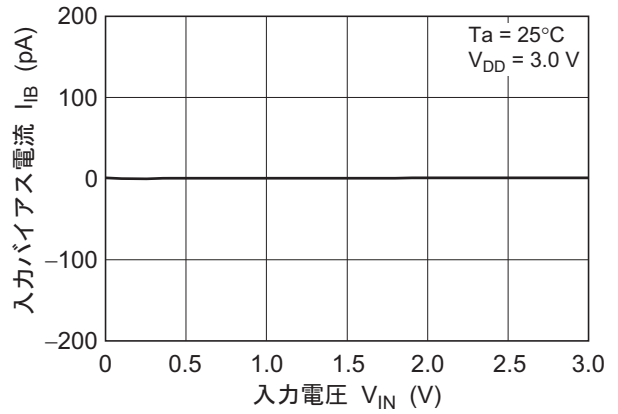


図 3-17. HA1630S03  
スルーレート (立ち上がり) 対 周囲温度特性

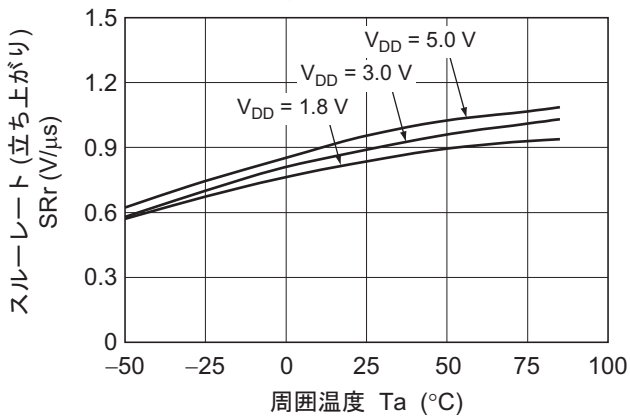


図 3-18. HA1630S03  
スルーレート (立ち下がり) 対 周囲温度特性

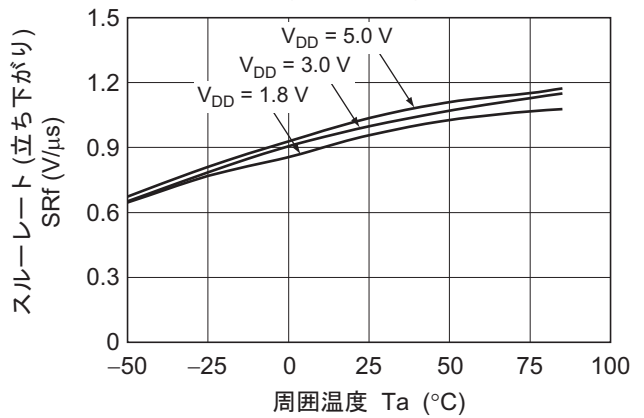


図 3-19. HA1630S03  
大振幅過渡応答特性

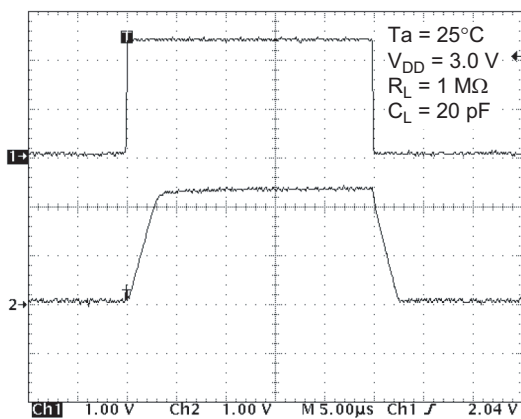
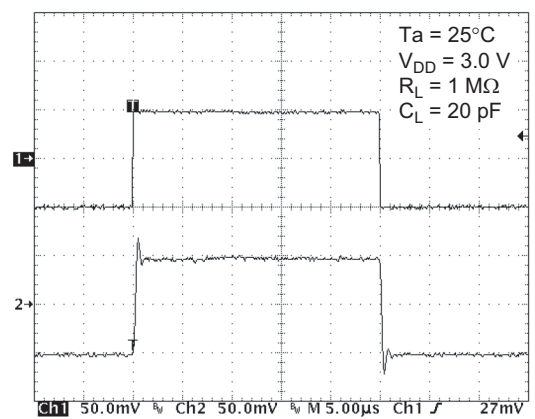
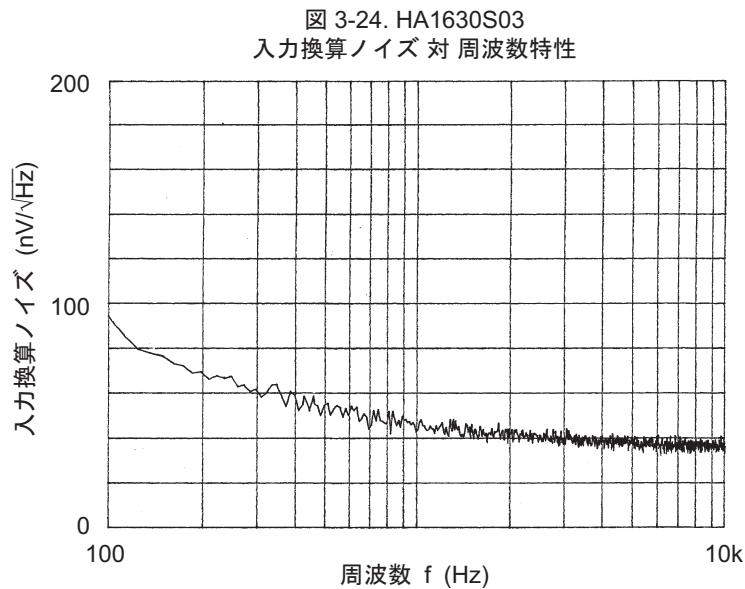
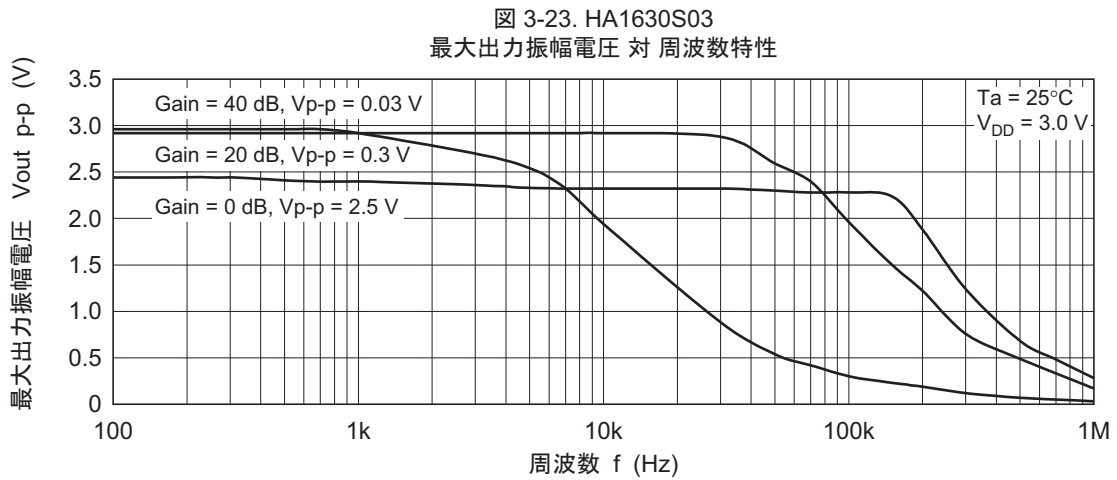
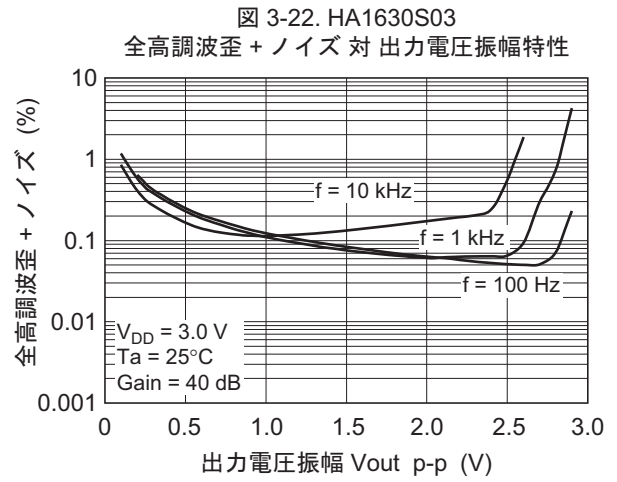
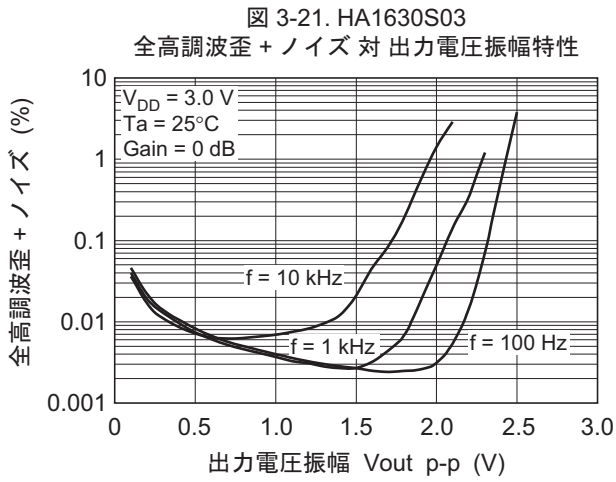


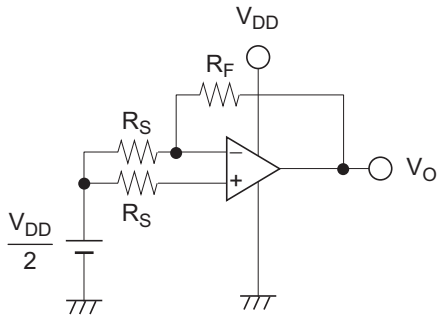
図 3-20. HA1630S03  
小振幅過渡応答特性





測定回路

1. 電源電圧除去比, PSRR & オフセット電圧,  $V_{IO}$



$V_{IO}$

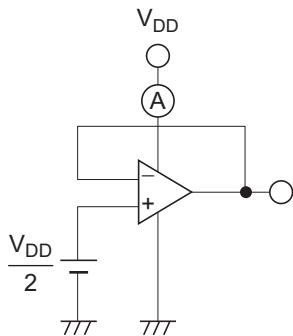
$$V_{IO} = \left( V_O - \frac{V_{DD}}{2} \right) \times \frac{R_S}{R_S + R_F}$$

PSRR

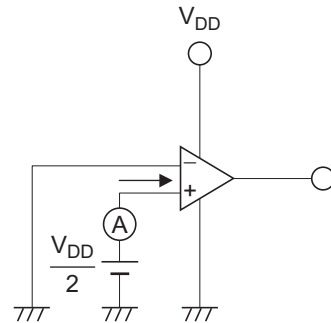
$$PSRR = -20 \log \left( \left| \frac{V_{O1} - V_{O2}}{V_{DD1} - V_{DD2}} \right| \times \frac{R_S}{R_S + R_F} \right)$$

$V_O$ をそれぞれの $V_{DD1} = 1.8\text{ V}$ と $V_{DD2} = 5.5\text{ V}$ に対応し測定する。

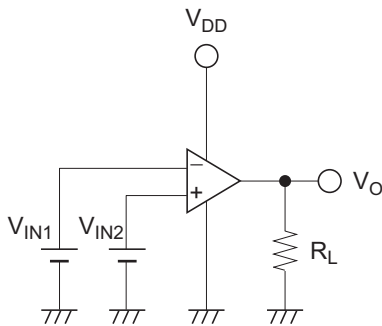
2. 消費電流,  $I_{DD}$



3. 入力バイアス電流,  $I_{IB}$



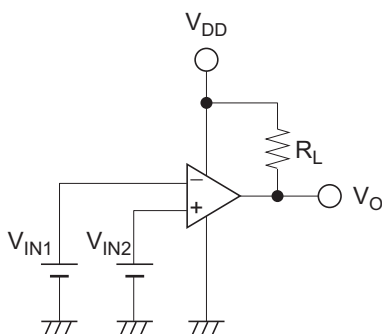
4. 出力ハイ電圧,  $V_{OH}$



$V_{OH}$

$$\begin{aligned} R_L &= 1\text{ M}\Omega \\ V_{IN1} &= V_{DD} / 2 - 0.05\text{ V} \\ V_{IN2} &= V_{DD} / 2 + 0.05\text{ V} \end{aligned}$$

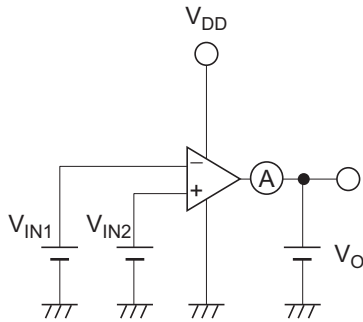
5. 出力ロー電圧,  $V_{OL}$



$V_{OL}$

$$\begin{aligned} R_L &= 1\text{ M}\Omega \\ V_{IN1} &= V_{DD} / 2 + 0.05\text{ V} \\ V_{IN2} &= V_{DD} / 2 - 0.05\text{ V} \end{aligned}$$

6. 出力ソース電流,  $I_{OSOURCE}$  & 出力シンク電流,  $I_{OSINK}$



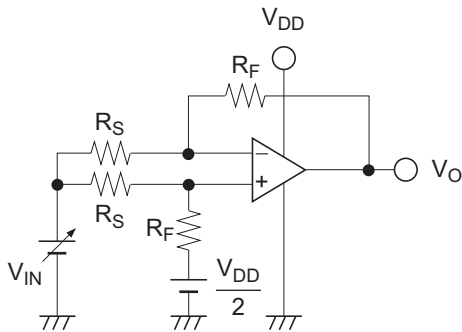
$I_{OSOURCE}$

$$\begin{aligned} V_O &= V_{DD} - 0.5 \text{ V} \\ V_{IN1} &= V_{DD} / 2 - 0.05 \text{ V} \\ V_{IN2} &= V_{DD} / 2 + 0.05 \text{ V} \end{aligned}$$

$I_{OSINK}$

$$\begin{aligned} V_O &= +0.5 \text{ V} \\ V_{IN1} &= V_{DD} / 2 + 0.05 \text{ V} \\ V_{IN2} &= V_{DD} / 2 - 0.05 \text{ V} \end{aligned}$$

7. 同相入力電圧範囲,  $V_{CM}$  & 同相弁別比, CMRR

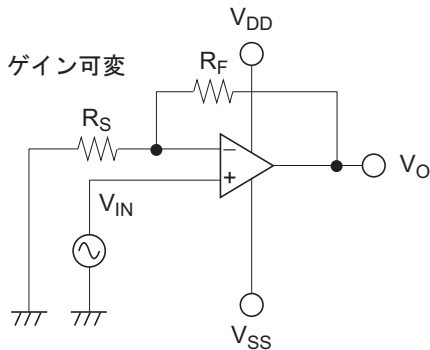


CMRR

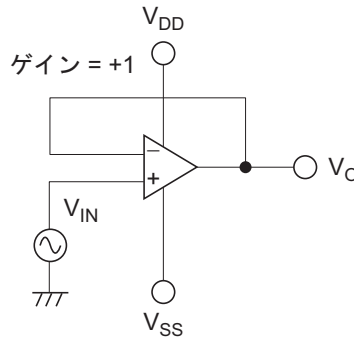
$$CMRR = -20 \log \left( \left| \frac{V_{O1} - V_{O2}}{V_{IN1} - V_{IN2}} \right| \times \frac{R_S}{R_S + R_F} \right)$$

$V_O$ をそれぞれの $V_{IN1} = 0 \text{ V}$ と $V_{IN2} = 2.1 \text{ V}$ に対応し測定する。

8. 全高調波歪, THD



ゲイン可変

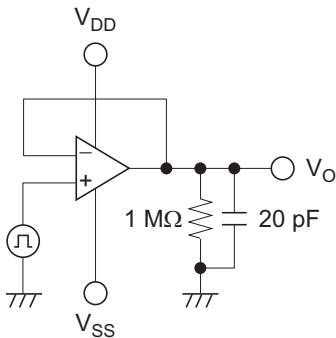


ゲイン = +1

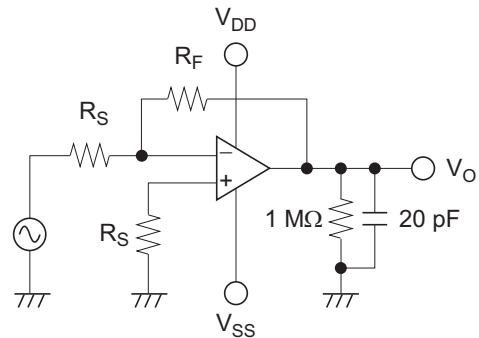
THD

ゲイン可変  
 $1 + R_F / R_S = 100$   
 freq = 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz

9. スルーレート, SR

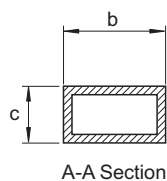
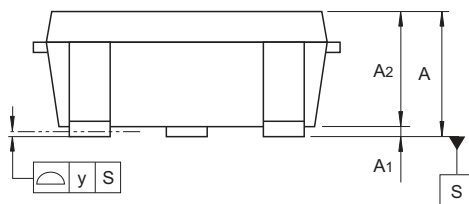
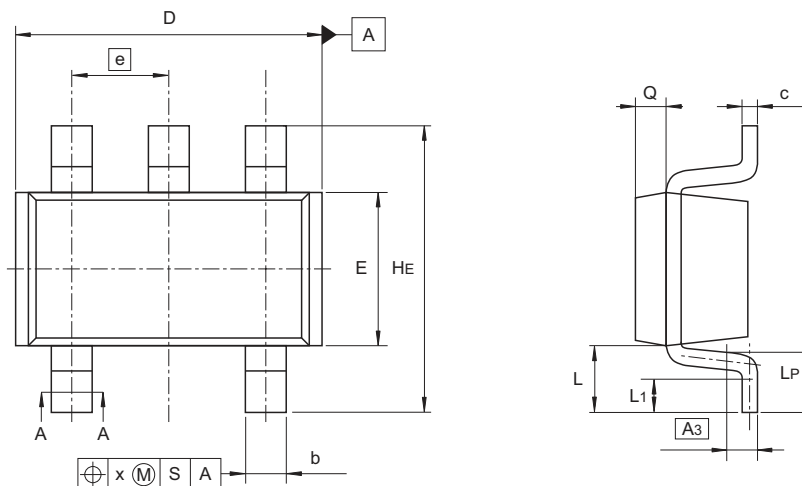


10. 電圧利得,  $A_V$  & 帯域幅, GBW



外形寸法図

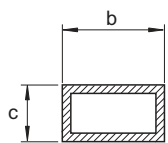
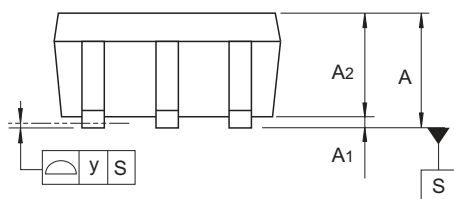
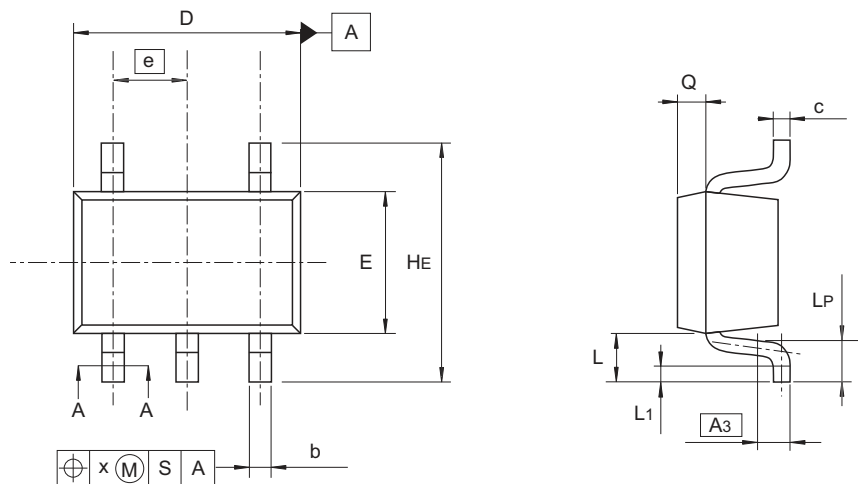
JEITA Package Code	RENESAS Code	Previous Code	MASS (Typ) [g]
SC-74A	PLSP0005ZB-A	MPAK-5 / MPAK-5V	0.015



Reference Symbol	Dimensions in millimeters		
	Min	Nom	Max
A	1.0	—	1.4
A <sub>1</sub>	0	—	0.1
A <sub>2</sub>	1.0	1.1	1.3
A <sub>3</sub>	—	0.25	—
b	0.35	0.4	0.5
c	0.11	0.16	0.26
D	2.8	2.95	3.1
E	1.5	1.6	1.8
e	—	0.95	—
H <sub>E</sub>	2.5	2.8	3.0
L	0.3	—	0.7
L <sub>1</sub>	0.1	—	0.5
L <sub>P</sub>	0.2	—	0.6
x	—	—	0.05
y	—	—	0.05
Q	—	0.3	—

© 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

JEITA Package Code	RENESAS Code	Previous Code	MASS (Typ) [g]
SC-88A	PTSP0005ZC-A	CMPAK-5 / CMPAK-5V	0.006



A-A Section

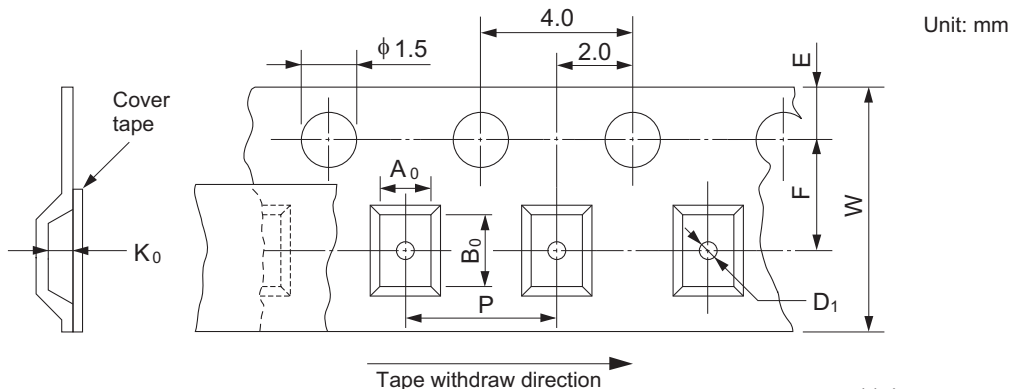
Reference Symbol	Dimensions in millimeters		
	Min	Nom	Max
A	0.8	—	1.1
A <sub>1</sub>	0	—	0.1
A <sub>2</sub>	0.8	0.9	1.0
A <sub>3</sub>	—	0.25	—
b	0.15	0.22	0.3
c	0.1	0.13	0.15
D	1.8	2.0	2.2
E	1.15	1.25	1.35
e	—	0.65	—
H <sub>E</sub>	1.8	2.1	2.4
L	0.3	—	0.7
L <sub>1</sub>	0.1	—	0.5
L <sub>P</sub>	0.2	—	0.6
x	—	—	0.05
y	—	—	0.05
Q	—	0.25	—

© 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

テーピング&リール仕様

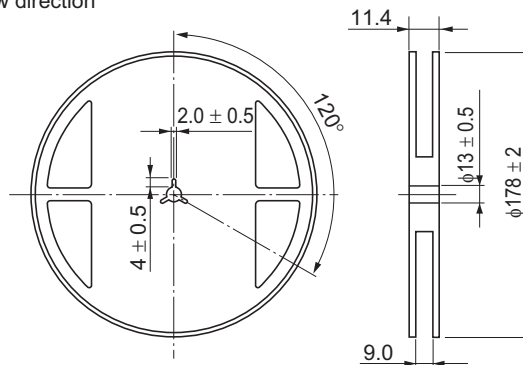
[テーピング]

パッケージ	W	P	Ao	Bo	Ko	E	F	D1	数量
MPAK-5	8	4	3.3	3.3	1.5	1.75	3.5	1.05	3,000 個/巻
CMPAK-5	8	4	2.25	2.45	1.1	1.75	3.5	1.05	3,000 個/巻



[リール]

パッケージ	テープ幅	W1	W2
MPAK-5	8	11.4	9
CMPAK-5	8	11.4	9



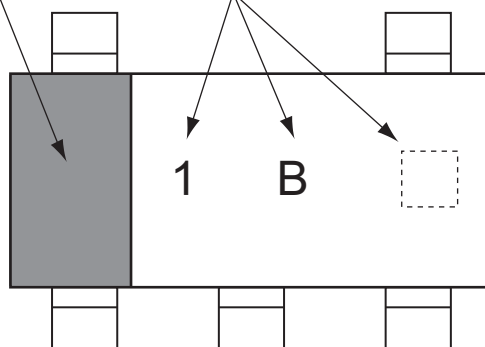
[受注単位]

個数
3,000 個

現品表示

インデックスバンド

マーク



1 A □ : HA1630S01

1 B □ : HA1630S02

1 C □ : HA1630S03

□ = コントロールコード  
( — または空白)



## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。  
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、  
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、  
防災・防犯装置、各種安全装置等  
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍用用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/contact/>